



บทที่ 6

โปรแกรมต้นแบบสำหรับวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นแบบท่อน

6.1 บทนำ

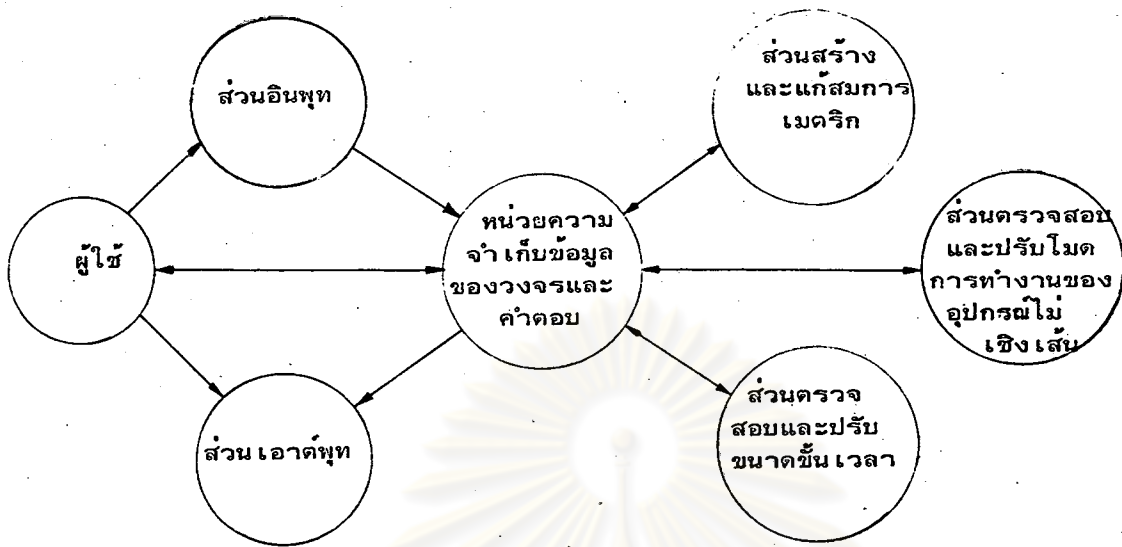
โปรแกรมต้นแบบสำหรับวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อนทั่วไปที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ให้ชื่อว่า 'TAPE' ย่อมาจาก A Transient Analysis Program for Piecewise Linear Electronic Circuits 'TAPE' เขียนขึ้นโดยใช้ภาษา Applesoft Basic เพื่อให้ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ Apple][หรือคอมพิวเตอร์รุ่นอื่นๆ ที่มีการใช้งานเหมือนกัน การที่เราเลือกใช้ภาษา Applesoft Basic ในการพัฒนาโปรแกรมก็เพราะ เป็นภาษาที่ใช้ง่าย สะดวกต่อการตรวจสอบที่ผิด (debug) และมีโปรแกรมช่วยในการพัฒนา (developing software tool) มากพอควร เช่น APA, PLE, D.BUG เป็นต้น 'TAPE' จะมีขีดความสามารถและคุณสมบัติดังนี้

- 1) ใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ แหล่งกำเนิดสัญญาณ ไดโอด ทราานซิสเตอร์ ออปแอมป์ และ สวิตช์
- 2) สามารถคำนวณผลตอบสนองเชิงเวลา (transient analysis) ได้
- 3) สามารถควบคุมความผิดพลาดและปรับขนาดขึ้นเวลาได้อัตโนมัติ
- 4) สำหรับเครื่อง Apple][ที่มีหน่วยความจำ 48K bytes 'TAPE' จะสามารถวิเคราะห์วงจรที่มีตัวแปรสูงสุดได้ถึง 28 ตัวแปร ซึ่งวงจรขนาดนี้จะมีประมาณ 27 โหมด และอาจมีองค์ประกอบได้ถึง 100 ตัว
- 5) ใช้งาน แก้ไขข้อมูลได้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไว้ในแผ่นจานแม่เหล็ก (Diskette) เพื่อเรียกออกมาวิเคราะห์หรือแก้ไขใหม่ภายหลังได้อีก
- 6) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นได้

บทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของขีดความสามารถและคุณสมบัติทั้ง 6 ข้อของ 'TAPE' เราจะกล่าวรายละเอียดในบทนี้โดยจะมุ่งไปที่โครงสร้างและวิธีการใช้งานของโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6.2 โครงสร้างโปรแกรมและโมดการทำงานของ 'TAPE'

โครงสร้างของโปรแกรมแบ่งออกได้เป็นโปรแกรมย่อยหลักอยู่ 5 โปรแกรมคือ ส่วนอินพุท ส่วนสร้างและแก้สมการเมตริก ส่วนเอาต์พุท ส่วนตรวจสอบเพื่อปรับภาวะการทำงาน ของอุปกรณ์ไม่เชิงเส้น และส่วนตรวจสอบและปรับขนาดขึ้นเวลาดังแสดงในรูปที่ 6.1 โปรแกรมย่อยหลักทั้ง 5 โปรแกรมนี้จะแบ่งการทำงานของ 'TAPE' ออกเป็น 2 โหมด ในขณะหนึ่ง จะมีชุดโปรแกรมย่อยเพียงโมดเดียวของ 'TAPE' เท่านั้นที่มีอยู่ในไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนอีก โหมดหนึ่งจะอยู่ในแผ่นจานแม่เหล็กที่เก็บชุดโปรแกรมย่อยทั้งสองไว้ โหมดทั้งสองนี้มีชื่อเรียกและมีหน้าที่โดยย่อดังนี้



รูปที่ 6.1 โครงสร้างหลักของโปรแกรม 'TAPE'

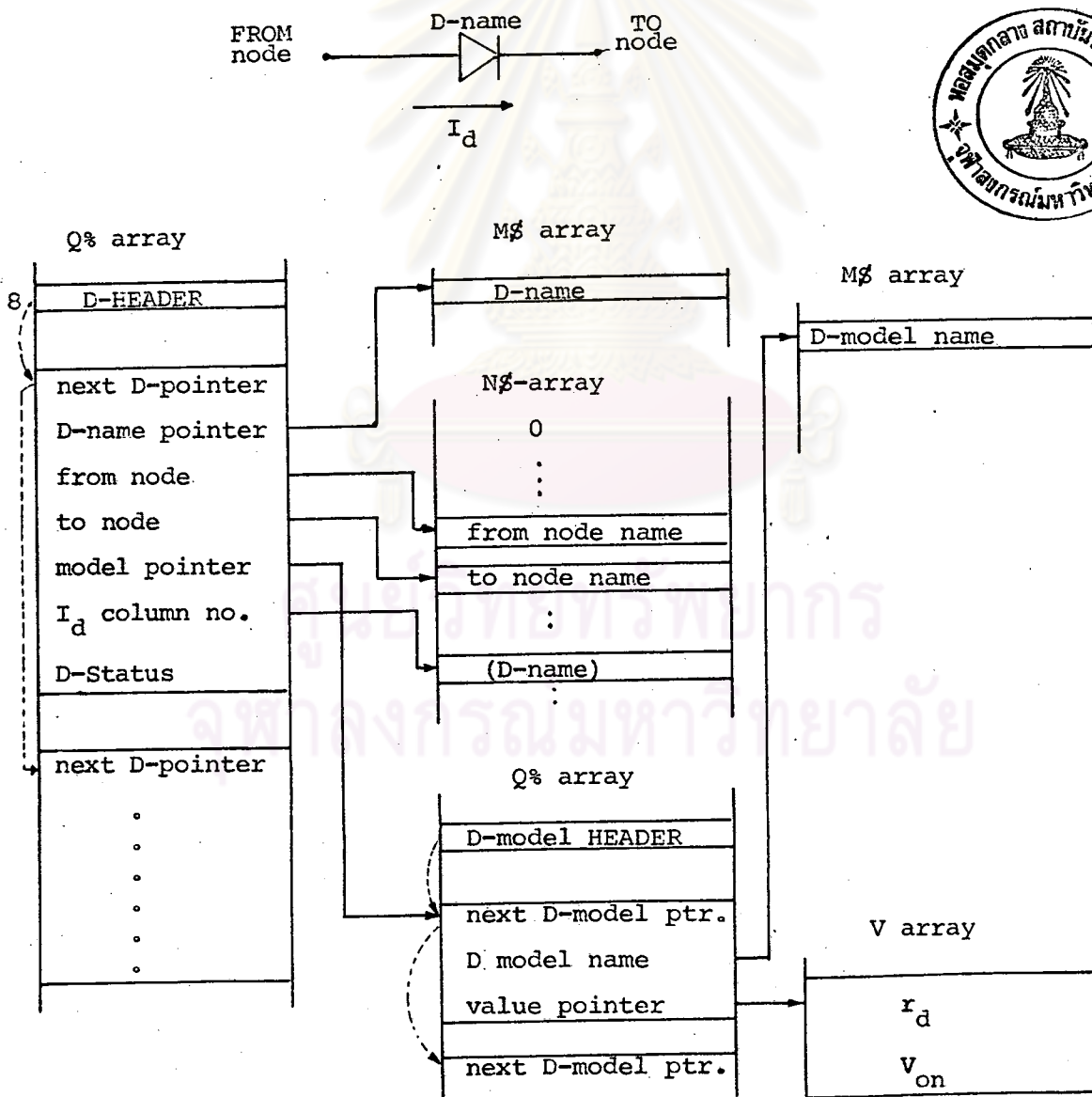
6.2.1 โมด INPUT เป็นโมดที่รับข้อมูลเกี่ยวกับวงจรจากผู้ใช้ ประกอบด้วยโปรแกรมส่วนอินพุตซึ่งทำหน้าที่ประมวลข้อมูลวงจรที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปและจัดระบบโครงสร้างในการเก็บข้อมูลแบบ linked list ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ใช้ในโปรแกรม 'เล็ก 1.0[3]' ทำให้สามารถสร้าง ดัดแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมวงจรได้ตามต้องการ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลของวงจรไว้ในจานแม่เหล็กและเรียกออกมาใช้ได้โดยง่าย

6.2.2 โมด SIM เป็นโมดที่ทำการวิเคราะห์วงจร ประกอบด้วยโปรแกรมส่วนสร้างและแก้สมการเมตริกของวงจร ส่วนตรวจสอบเพื่อปรับภาวะการทำงานของอุปกรณ์ไม่เชิงเส้น ส่วนตรวจสอบและปรับขนาดขึ้นเวลาและส่วนเอาต์พุต ในโมดนี้โปรแกรมจะรับคำสั่งในด้านที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจร เช่น กำหนดขนาดขึ้นเวลา h ขนาด LTE ช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ เวลาที่เริ่มทำการวิเคราะห์ และ พิมพ์ผลการวิเคราะห์เป็นต้น ข้อมูลของวงจรที่ผู้ใช้วิเคราะห์จะรับมาจากโมด INPUT โดยการเก็บพื้นที่ส่วนบนของหน่วยความจำ RAM เป็นที่เก็บข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกันระหว่าง โมดทั้งสอง และในบางกรณีก็สามารถรับข้อมูลของวงจรมาจากจานแม่เหล็กได้ ในระหว่างการวิเคราะห์วงจร SIM จะไม่ติดต่อกับผู้ใช้จนกว่าจะวิเคราะห์เสร็จและเข้าสู่โปรแกรมส่วนเอาต์พุตแล้วเท่านั้น

รายละเอียดของโปรแกรมน้อยหลักร่างๆ และการใช้งานในแต่ละโมดจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป

6.3 ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานในโมด INPUT

ในโมด INPUT โปรแกรมจะทำหน้าที่รับข้อมูลเกี่ยวกับวงจรและคำสั่งอื่นๆ ในลักษณะโต้ตอบ (interactive) กับผู้ใช้ ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปจะถูกประมวลผลแล้วเก็บไว้ใน array สี่ชุดด้วยกันคือ array Q% array V array N% และ array M% Q% เป็น array หลักในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละตัว โครงสร้างข้อมูลใน Q% จะเป็นแบบ linked list คือ เก็บตัวชี้ (pointer) เพื่อไปค้นหาชื่อของอุปกรณ์ใน array M% ค่าของอุปกรณ์ใน array V ชื่อโนดที่อุปกรณ์ต่ออยู่ใน array N% และยังมีชื่อตำแหน่งของอุปกรณ์ชนิดเดียวกันที่อยู่ในตำแหน่งติดไปด้วย นอกจากนี้ข้อมูลที่สำคัญบางอย่างเช่น ตำแหน่งของตัวแปรกระแส และ ภาวะการทำงานของอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นก็ยังเก็บไว้ใน array Q% เช่นกัน ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 แสดงการเก็บข้อมูลของไดโอด

อุปกรณ์ทุกตัวจะมี HEADER ของตัวมันเองอยู่ส่วนบนของ Q% array ดังเช่นในรูปที่ 6.2 HEADER ของไดโอดอยู่ที่ตำแหน่ง Q% (8) ซึ่งข้อมูลใน HEADER นี้จะชี้ไปที่ตำแหน่งชุดข้อมูลของไดโอด และส่วนบนสุดของชุดข้อมูลแต่ละชุดก็จะมีตัวชี้ (pointer) บอกตำแหน่งชุดข้อมูลของอุปกรณ์ชนิดเดียวกันที่อยู่ถัดไป การบอกตำแหน่งชุดข้อมูลของอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเป็นทอดๆ นี้ ทำให้เราสามารถค้นหา แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยง่ายไม่ต้องพะวงถึงการจัดกลุ่มอุปกรณ์ และยังทำให้การแสดงผล (display) ข้อมูลของวงจรเป็นหมวดหมู่ของแต่ละอุปกรณ์อย่างมีระเบียบด้วย

ชื่อของโนดที่อุปกรณ์ค้อยู่ในวงจรที่ไข้อนข้อมูลเข้าไปจะถูกตรวจสอบกับชื่อของโนดที่มีอยู่แล้วใน N% array ถ้าชื่อโนดนั้นมีอยู่แล้ว ตำแหน่งของมันใน N% array ก็จะถูกเก็บไว้ใน Q% array แต่ถ้าชื่อโนดเป็นโนดใหม่ N% array ก็จะเพิ่มขนาดขึ้นอีกหนึ่งและจะเก็บชื่อโนดใหม่นั้นไว้ ส่วนตำแหน่งของมันก็จะถูกเก็บไว้ใน Q% array เช่นเดิม ด้วยวิธีการเช่นนี้ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ความจริงแล้วตำแหน่งของชื่อโนดที่เก็บไว้ใน Q% array ก็จะเป็นตำแหน่ง row และ column ที่จะไหลลข้อมูลของตารางประจำอุปกรณ์ในการสร้างสมการเมตริกของวงจร และขนาดของ N% array ก็เท่ากับขนาด (dimension) ของสมการเมตริกวงจรมันเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้า N% array มีขนาด 1x5 เมตริกจัตุรัสของสมการวงจรจะมีขนาด 5x5

สำหรับอุปกรณ์บางอย่างเช่น ตัวเหนี่ยวนำ ออปแอมป์ ไดโอด สวิตช์ และแหล่งจ่ายแรงดันที่ต้องมีตัวแปรกระแสดของตัวมันเองเป็นตัวแปรของสมการวงจรเพิ่มขึ้นมานั้น โปรแกรม 'TAPE' จะจัดการเพิ่มขนาดของ N% array และกำหนดชื่อของตัวแปรกระแสเป็นชื่อเดียวกับองค์ประกอบโดยอัตโนมัติซึ่งจะทำในโมด SIM นั่นคือจะทำหลังจากที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลของวงจรเสร็จและเริ่มทำการวิเคราะห์แล้ว ตามตัวอย่างในรูป 6.2 จะเห็นว่าตำแหน่ง Id column no. ใน Q% array จะชี้ไปยังชื่อของไดโอด (D-name) ใน N% array ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมโมด SIM เพื่อกำหนดตัวแปรกระแสไดโอดและตำแหน่งสำหรับไหลลข้อมูลขององค์ประกอบในสมการเมตริกของวงจร

ออปแอมป์ ไดโอด และทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีค่าพารามิเตอร์ประจำตัวและผู้ใช้สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ ยกตัวอย่างเช่นไดโอดในรูป 6.2 เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลของไดโอดในด้านของการต่อไดโอดในวงจร คือ D-name, from node, to node และกำหนดชื่อของเบอร์ไดโอดเช่น 1N4001 เป็นต้น โปรแกรมก็จะทำการค้นหาชื่อเบอร์นั้นใน M% array ถ้าไดโอดเบอร์นั้นมีอยู่แล้ว model pointer ใน Q% array ก็จะชี้ไปยังชุดข้อมูลของเบอร์ค่าสมบัติของไดโอดใน array เดียวกัน แต่ถ้าเป็นเบอร์ใหม่โปรแกรมจะเตรียมที่ใน Q% array ขึ้นมาไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ใส่ค่าพารามิเตอร์ในภายหลัง

อุปกรณ์ไม่เชิงเส้นที่มีการทำงานในหลายๆ ภาวะ รหัสของภาวะการทำงานในภาวะปัจจุบันก็จะเก็บไว้ใน Q% array ด้วยเช่นในตัวอย่างของไดโอดนั้น ถ้าตำแหน่ง D-STATUS เป็น 1 หมายถึงไดโอดกำลังอยู่ในภาวะนำกระแส และถ้า D-STATUS เป็น 0 ไดโอดจะอยู่ในภาวะไม่นำกระแส เป็นต้น

ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น ความเหนี่ยวนำ (inductance) ความต้านทาน (resistance) และอื่นๆ ตลอดจนค่าในอดีตของตัวแปรสถานะเพื่อใช้สำหรับการคำนวณหาค่าตอบและ LTE ของวงจรที่เวลาปัจจุบันจะถูกเก็บไว้ใน V array และตำแหน่งใน V array จะถูกชี้โดย Value pointer ใน Q% array ดังตัวอย่างในรูปที่ 6.2 ในชุดข้อมูลของพารามิเตอร์ของไดโอด (Diode Model) จะมี Value pointer เป็นตัวชี้ไปยังค่าสมมติ คือ ความต้านทานขณะนำกระแส (r_D) และ แรงดันนำกระแส (V_{ON}) ใน V array

ที่กล่าวมานี้เป็น การอธิบายลักษณะการเก็บและการค้นหาข้อมูลของวงจรอย่างสังเขป ส่วนการใช้งานในโหมด INPUT นั้นง่าย ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องพะวงถึงการเก็บข้อมูลที่กล่าวมา เพราะโปรแกรมจะทำหน้าที่ป้อนคำถามผู้ใช้เพียงแต่เลือกหรือใส่ข้อมูลที่ต้องการลงไปเท่านั้น ในโหมด INPUT มีคำสั่งให้เลือกอยู่ 7 คำสั่งด้วยกัน ดังแสดงในรูป 6.3 ผู้ใช้เพียงแต่กดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการใช้ซึ่งเราจะได้อธิบายความหมายและการใช้งานของคำสั่งทั้ง 7 ในหัวข้อต่อไป

```
PWR ELECTRONIC PROG MODE
<1> EDIT
<2> SIM
<3> LOAD
<4> SAVE
<5> CHANGE
<6> DISPLAY
<7> QUIT
```

INPUT MODE NUMBER YOU WANT: :

รูปที่ 6.3 การแสดงผลบนจอภาพในโหมด INPUT

6.4 คำสั่ง EDIT

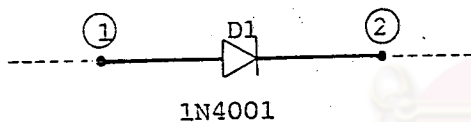
คำสั่งนี้ใช้สั่งให้โปรแกรมรับข้อมูลของวงจรจากผู้ใช้เข้ามาประมวลผลและเก็บไว้ใน array ทั้งสี่ที่ได้กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะแสดงการป้อนข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชนิดควบคู่ไปกับลักษณะการเก็บข้อมูลใน array ทั้งสี่ด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้เลือกคำสั่ง EDIT โดยการกดเลข 1 แล้วโปรแกรมจะเข้าสู่เมนูย่อยดังในรูปที่ 6.4 เพื่อให้ใส่อักษรย่อของอุปกรณ์ที่ต้องการลงไว้

PUT R, L, C, Q, O, SW, V, I, QM, OM, D, DM, OR END:

R = RESISITOR	QM = MODEL TRANSISTOR
C = CAPACITOR	OM = MODEL OPAMP
L = INDUCTOR	D = DIODE
Q = TRANSISTOR	SW = CONTROLLED SWITCH
O = OPAMP	DM = MODEL DIODE
V = VOLTAGE SOURCE	END = OUT OF EDIT MODE
I = CURRENT SOURCE	

รูปที่ 6.4 ข้อมูลบนจอภาพเมื่อเข้าสู่โหมด EDIT

ถ้าต้องการป้อนข้อมูลของไดโอดในรูปที่ 6.5 (ก) ก็ให้กดตัว "D" จอภาพจะแสดงผลในรูปที่ 6.5 (ข) ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลลงไป (ตัวที่ขีดเส้นใต้) ให้ครบเสร็จแล้วโปรแกรมจะจัดข้อมูลใน array ทั้งสี่ตัวในรูปที่ 6.2 และก็จะกลับมาตามผู้ใช้ใหม่ดังในรูปที่ 6.4 เมื่อกำหนดค่าสิ่งนี้จะสิ้นสุดลงและโปรแกรมจะกลับไปพิมพ์เมนูของโหมด INPUT ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ป้อนคำสั่ง "END"



EDIT DIODE

```

1  D-NAME: D1
2  FR NODE: 1
3  TO NODE: 2
4  D-MODEL: 1N4001
5  D STATUS: 1

```

STATUS : 0 = OFF 1 = ON

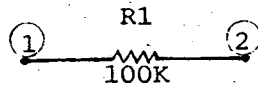
(ก) ไดโอด D1 อยู่ในโหมดนำกระแส

(ข) การป้อนข้อมูลของไดโอด

รูปที่ 6.5 การป้อนข้อมูลของไดโอด

สำหรับการป้อนข้อมูลของอุปกรณ์อย่างอื่น ๆ เราจะทำให้เป็นรูปการแสดงผลบนจอภาพและการจัดข้อมูลใน array เท่านั้น จะไม่ขอก้าวในรายละเอียดเนื่องจากวิธีการคิดและประมวลผลนั้นเหมือนๆ กันที่ได้กล่าวมาแล้วในตัวอย่างของไดโอด

6.4.1 ตัวต้านทาน



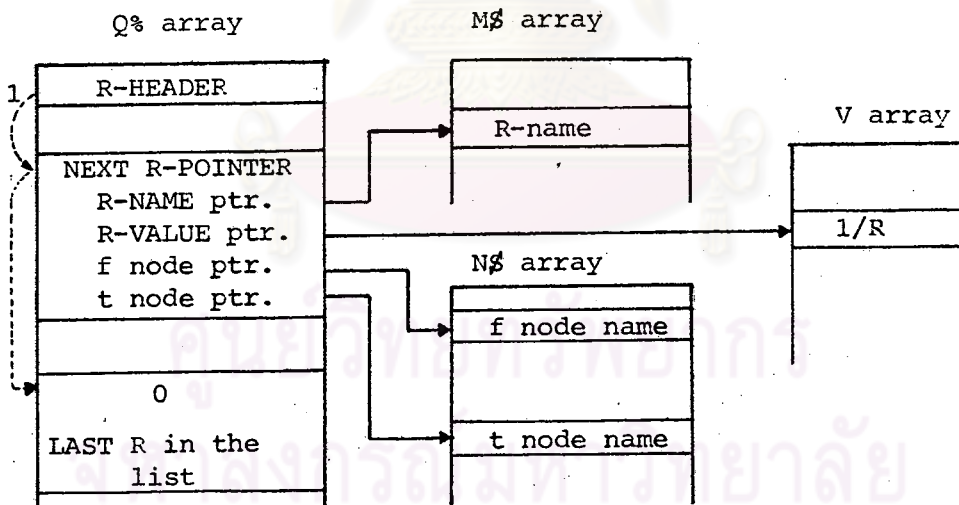
EDIT RESISTOR

```

1  R-NAME:: R1 }
2  R-VALUE: 100K }
3  FR-NODE: 2 }
4  TO-NODE: 1 }
    
```

หมายเหตุ ในช่อง R-VALUE: K = 10^3
 MEG = 10^6
 U = 10^{-6}
 P = 10^{-12}
 M = 10^{-3}

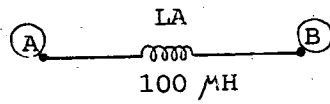
(ก)



(ข)

รูปที่ 6.6 การใส่ข้อมูลของความต้านทาน (ก) การแสดงผลบนจอภาพ
 (ข) การจัดข้อมูลใน array

6.4.2 ตัวเหนี่ยวนำ

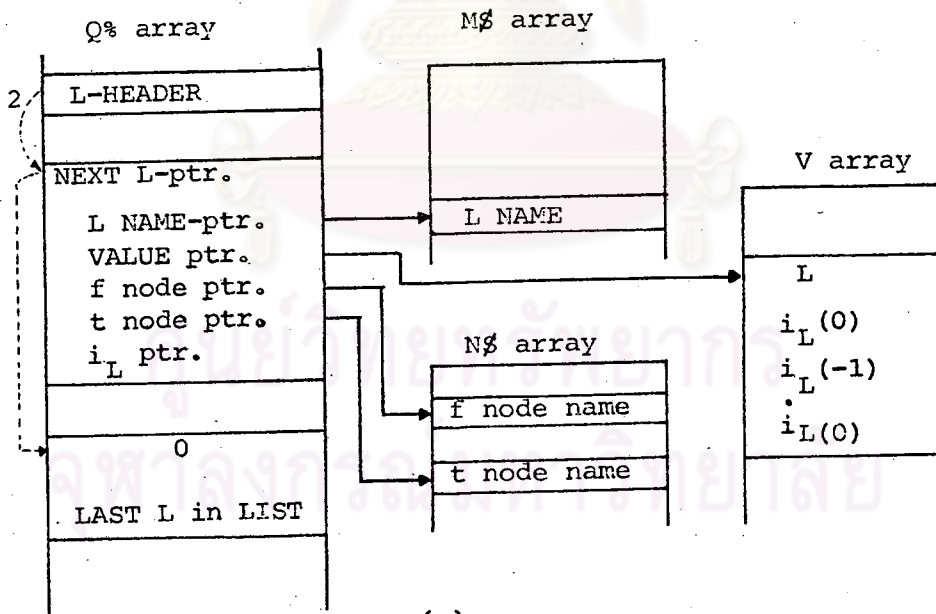


EDIT INDUCTOR

- 1 L-NAME: LA)
- 2 L-VALUE: 100U)
- 3 FR NODE: A)
- 4 TO NODE: B)
- 5 I PAST1:)
- 6 I PAST2:)
- 7 SLOPE I:)

หมายเหตุ ในข้อ 5, 6 และ 7 เป็นการใส่ค่าเริ่มต้น (Initial condition) ของตัวเหนี่ยวนำ ถ้าผู้ใช้ไม่ทราบก็ไม่ต้องใส่อะไรเลย

(ก)

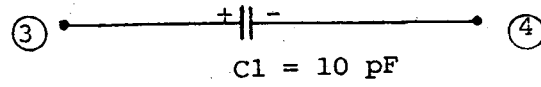


(ข)

รูปที่ 6.7 การใส่ข้อมูลของตัวเหนี่ยวนำ

6.4.3 ตัวเก็บประจุ

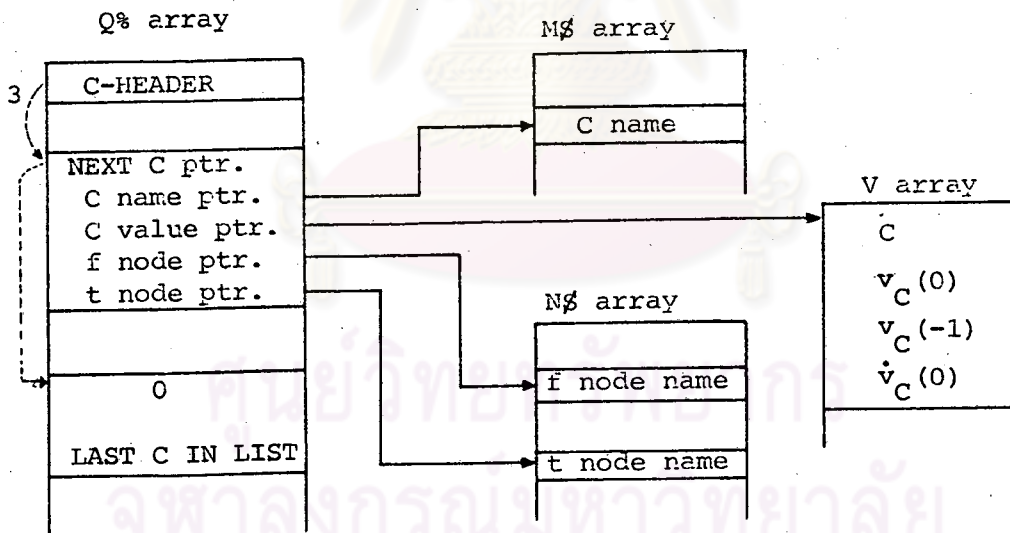
$$V_C(0) = 5 \text{ Volts}$$



EDIT CAPACITOR

- 1 C-NAME: C1
- 2 C-VALUE: 10P
- 3 FR NODE: 3
- 4 TO NODE: 4
- 5 V PAST1: 5
- 6 V PAST2:
- 7 SLOPE V:

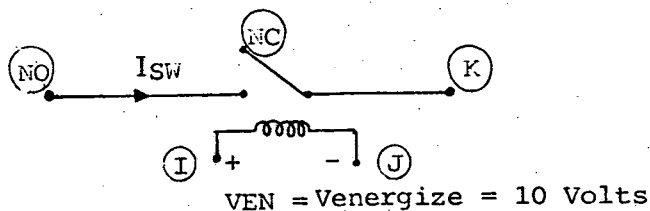
(ก)



(ข)

รูปที่ 6.8 การใส่ข้อมูลของตัวเก็บประจุ

6.4.4 สวิตช์

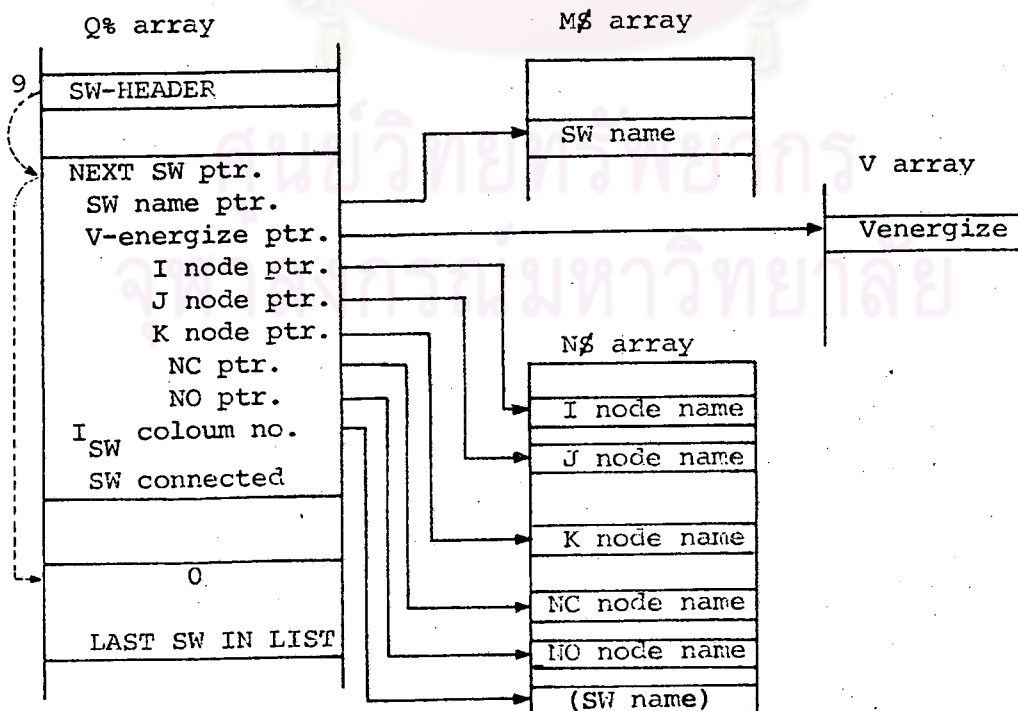


EDIT CONTROLLED SWITCH

- 1 SW-NAME: SW2 }
- 2 V-SWITCH: 10 }
- 3 I-NODE: I }
- 4 J-NODE: J }
- 5 K-NODE: K }
- 6 NC-NODE: NC }
- 7 NO-NODE: NO }
- 8 INITIAL: NC }

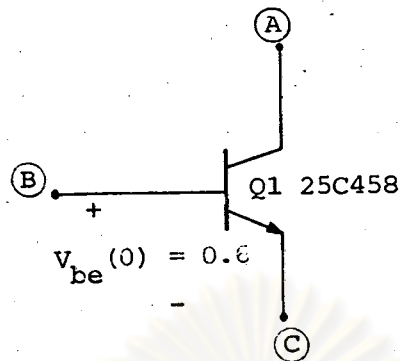
หมายเหตุ ในข้อ 6 และ 7 ถ้าโหนด NC หรือ NO เป็นโหนดลอยไว้เฉยๆ ให้ใส่คำว่า "NC" เพื่อบอกให้โปรแกรมรับรู้ ส่วนข้อ 8 เป็นการกำหนดภาวะเริ่มต้นของสวิตช์ว่าต่อกับโหนดใดอยู่

(ก)



(ข)

รูปที่ 6.9 การใส่ข้อมูลของสวิตช์

6.4.5 ทรานซิสเตอร์

EDIT TRANSISTOR

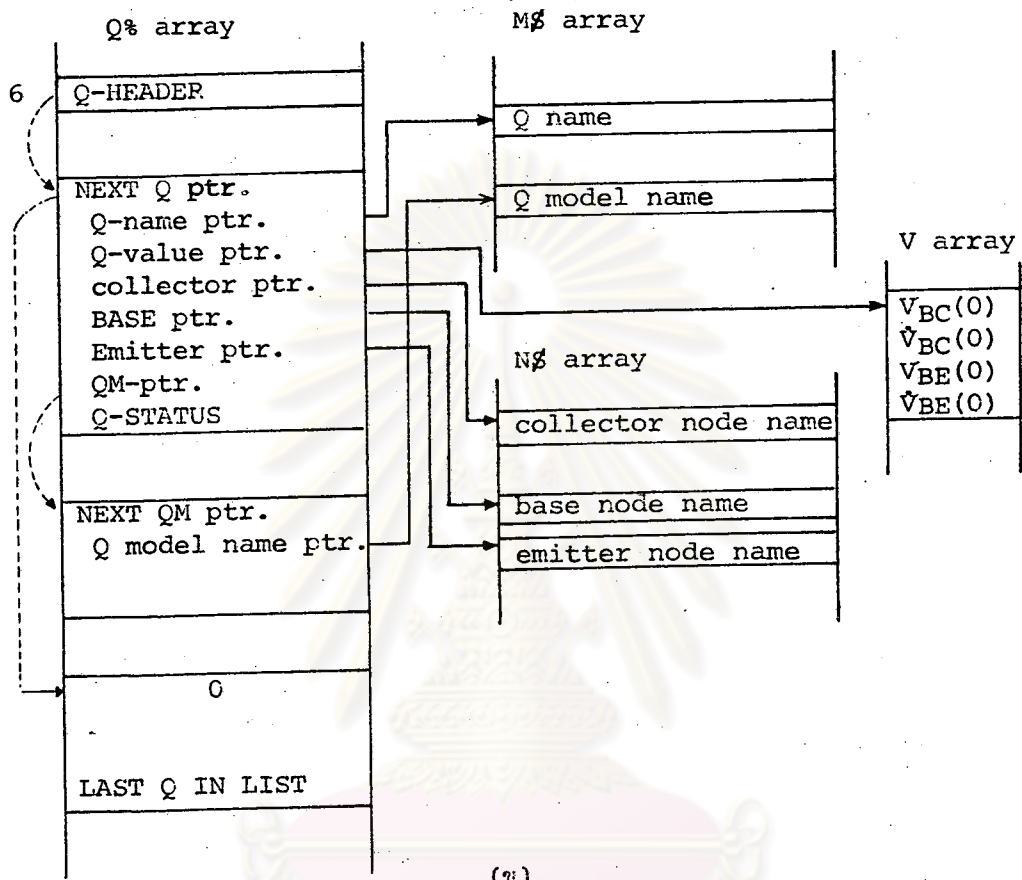
- 1 Q-NAME:: Q1)
- 2 C-NODE:: A)
- 3 B-NODE:: B)
- 4 E-NODE:: C)
- 5 Q-MODEL: 25C458)
- 6 Vbc PAST:)
- 7 Vbe PAST: 0.6)
- 8 Q-STATUS: 1)

STATUS : 0=CUT OFF 1=ACTIVE 2=SATURATE 3=REV ACT

หมายเหตุ ในข้อ 8 ; Q-STATUS คือภาวะหรือโหมด
การทำงานเริ่มต้นของทรานซิสเตอร์

(ก)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 6.10 การใส่ข้อมูลของทรานซิสเตอร์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.4.6 ค่าพารามิเตอร์ประจำเบอร์ทรานซิสเตอร์ (Q-model)

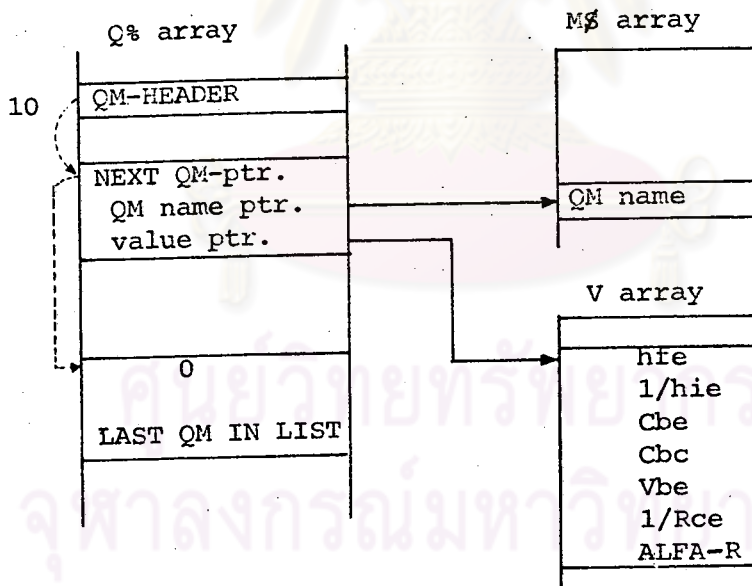
EDIT MODEL TRANSISTOR

```

1  MODEL NAME      : 25C458)
2  HFE VALUE < 100.00 > : 400)
3  1/hie VAL < 1E-3 > : 1E-3)
4  Cbe VALUE < 0.00 > : )
5  Cbc VALUE < 0.00 > : )
6  Vbe VALUE < 0.6 > : 0.6)
7  1/RCE VAL < 0.00 > : 1E-9)
8  ALFA R VAL < 0.5 > : 0.4)
    
```

หมายเหตุ ตัวเลขในเครื่องหมาย "< >" คือ ค่าพารามิเตอร์โดยทั่วไปของทรานซิสเตอร์ ส่วนในข้อ 6 ถ้าใส่ V_{be} เป็นเลขบวกจะหมายถึงทรานซิสเตอร์แบบ NPN ถ้า V_{be} เป็นเลขลบจะหมายถึงทรานซิสเตอร์แบบ PNP

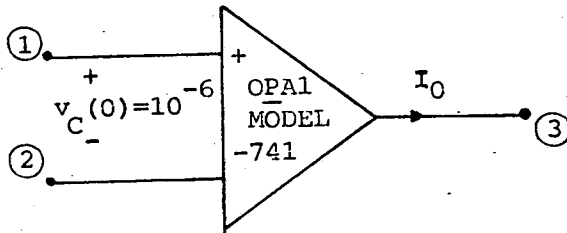
(ก)



(ข)

รูปที่ 6.11 การใส่ค่าพารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์

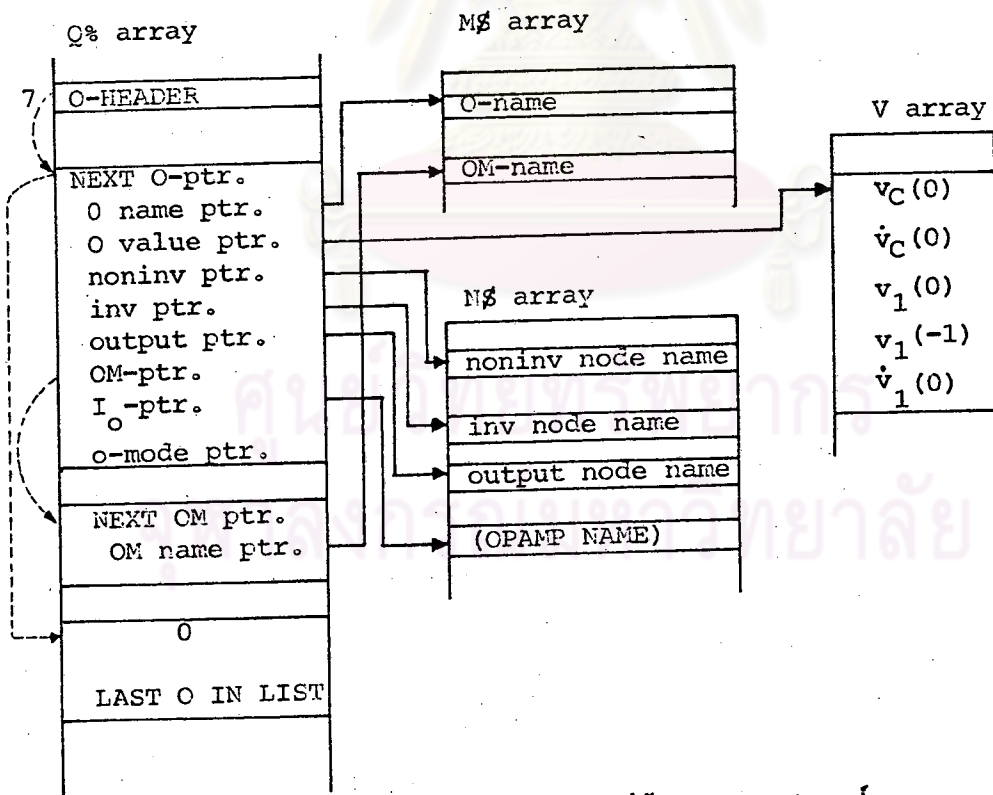
6.4.7 ออปแอมป์



EDIT OPAMP

- 1 OPAMP NAME: OPAL }
- 2 NONINV NODE: 1 }
- 3 INVER NODE: 2 }
- 4 OUTP NODE : 3 }
- 5 MODEL-TYPE: 741 }
- 6 VC PAST#1 : 1E-6 }
- 7 VO PAST#1 : }
- 8 VO PAST#2 : }
- 9 OPAMP STATUS1 }

STATUS : 0=ACT 1=POS SAT 2=NEG SAT



รูปที่ 6.12 การใส่ข้อมูลของออปแอมป์

6.4.8 ค่าพารามิเตอร์ของออปแอมป์ (Model Opamp)

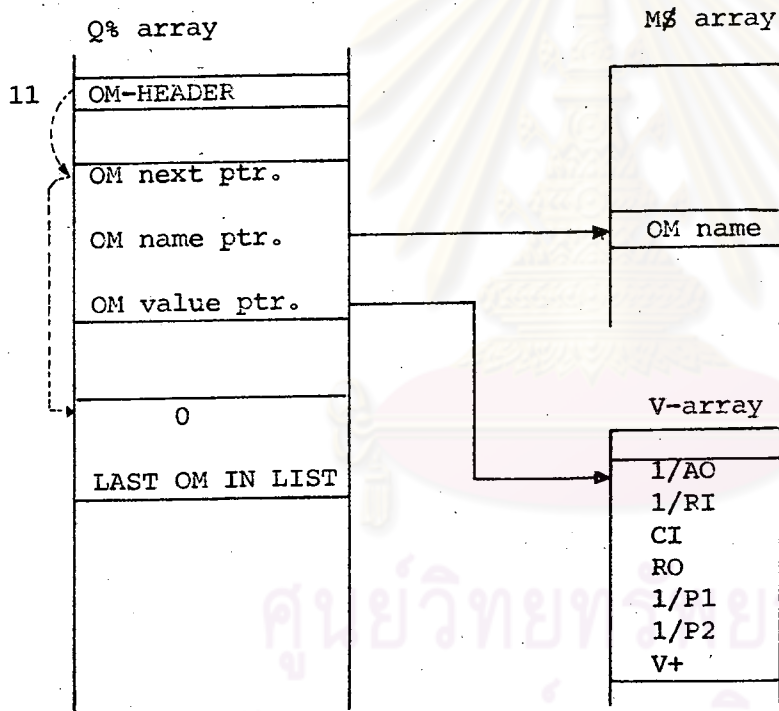
EDIT MODEL OPERATIONAL AMPLIFIER

```

1  MODEL NAME      ): 741 }
2  AO-VALUE < 1E+10 ): 1E+5 }
3  RI-VALUE < 1E+10 ): 10K }
4  CI-VALUE < 0.00  ):    }
5  RO-VALUE < 0.0   ): 10 }
6  POLE FREQ NR 1 ): 10 }
7  POLE FREQ NR 2 ): 1MEG }
8  V-LIMITER < 100  ): 15 }

```

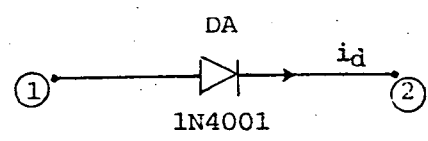
หมายเหตุ ในข้อ 8 V-LIMITER คือแรงดันเอาต์พุตในภาวะอิ่มตัว
(ก)



(ข)

รูปที่ 6.13 การใส่ค่าพารามิเตอร์ของออปแอมป์

6.4.9 ไดโอด

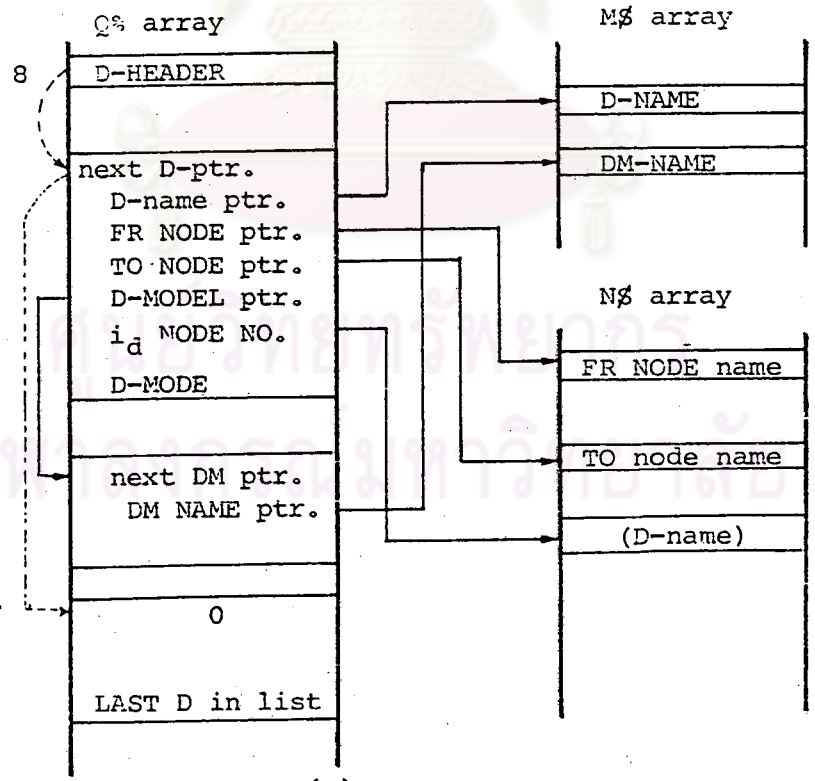


EDIT DIODE

- 1 D-NAME : DA }
- 2 FR NODE: 1 }
- 3 TO NODE: 2 }
- 4 D-MODEL: 1N4001 }
- 5 D-STATUS: 1 }

STATUS : 0=D OFF 1=D ON

(ก)



(ข)

รูปที่ 6.14 การใส่ข้อมูลของไดโอด

6.4.10 ค่าพารามิเตอร์ของไดโอด (Model Diode)

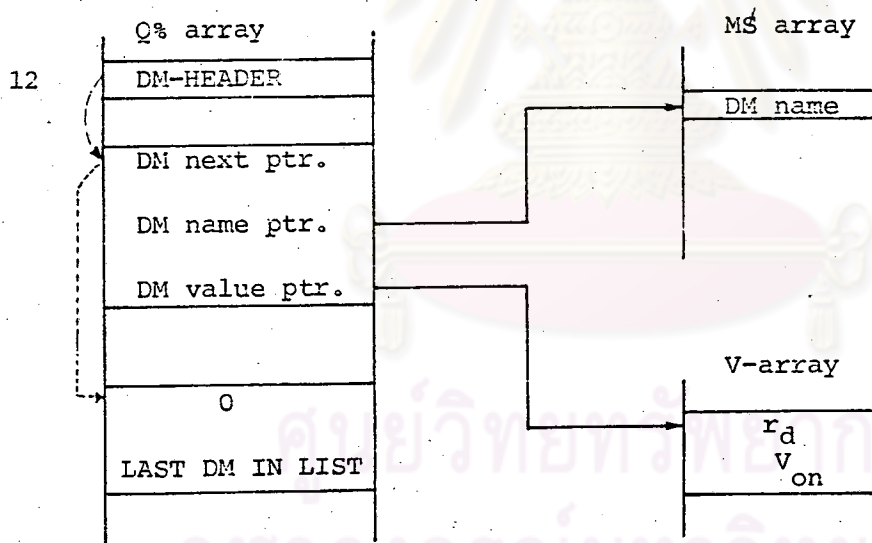
EDIT D-MODEL

```

1  DM-NAME  :1N4001 )
2  RD-VALUE :10 )
3  Von-VAL :0.6 )

```

(ก)



(ข)

รูปที่ 6.15 การใส่ค่าพารามิเตอร์ของไดโอด

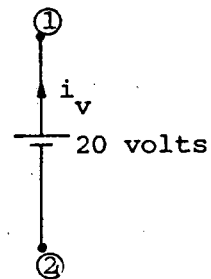
6.4.11 แหล่งกำเนิดแรงดัน

แหล่งจ่ายแรงดันเรามีให้ผู้ใช้เลือก 3 ชนิดคือ แหล่งจ่ายไฟตรง (DC) แหล่งจ่ายไฟสลับ (AC) และแหล่งจ่ายแรงดันเชิงเส้นแบบท่อน (PWL) ซึ่งลักษณะการใส่ข้อมูลแสดงไว้ในรูป 6.16 (ก) 6.16 (ข) และ 6.16 (ค) ตามลำดับ ส่วนการเก็บข้อมูลใน array ของแหล่งกำเนิดแรงดันทั้ง 3 ชนิดแสดงไว้ในรูปที่ 6.16 (ง)

EDIT VOLTAGE SOURCE

TYPE OF VOLTAGE SOURCE): DC)
 V-SOURCE NAME: V1)
 FR NODE: 1)
 TO NODE: 2)
 :::DC-VOLTAGE SOURCE:::
 DC-VALUE: 20)

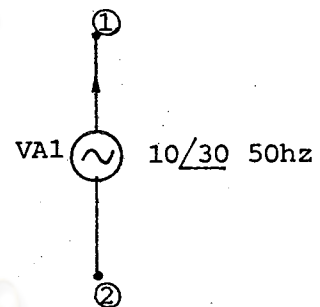
(ก)



EDIT VOLTAGE SOURCE

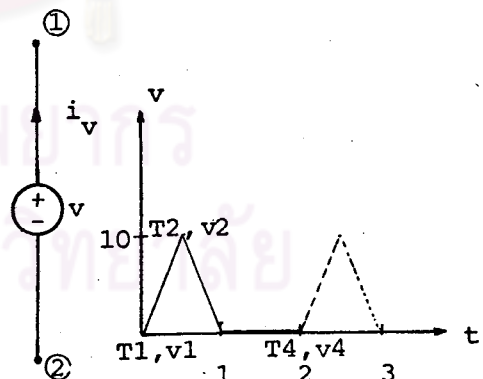
TYPE OF VOLTAGE SOURCE): AC)
 V-SOURCE NAME: VA1)
 FR NODE: 1)
 TO NODE: 2)
 :::AC-VOLTAGE SOURCE:::
 MAGNITUDE: 10) FREQUENCY: 50)
 PHASE : 30)

(ข)



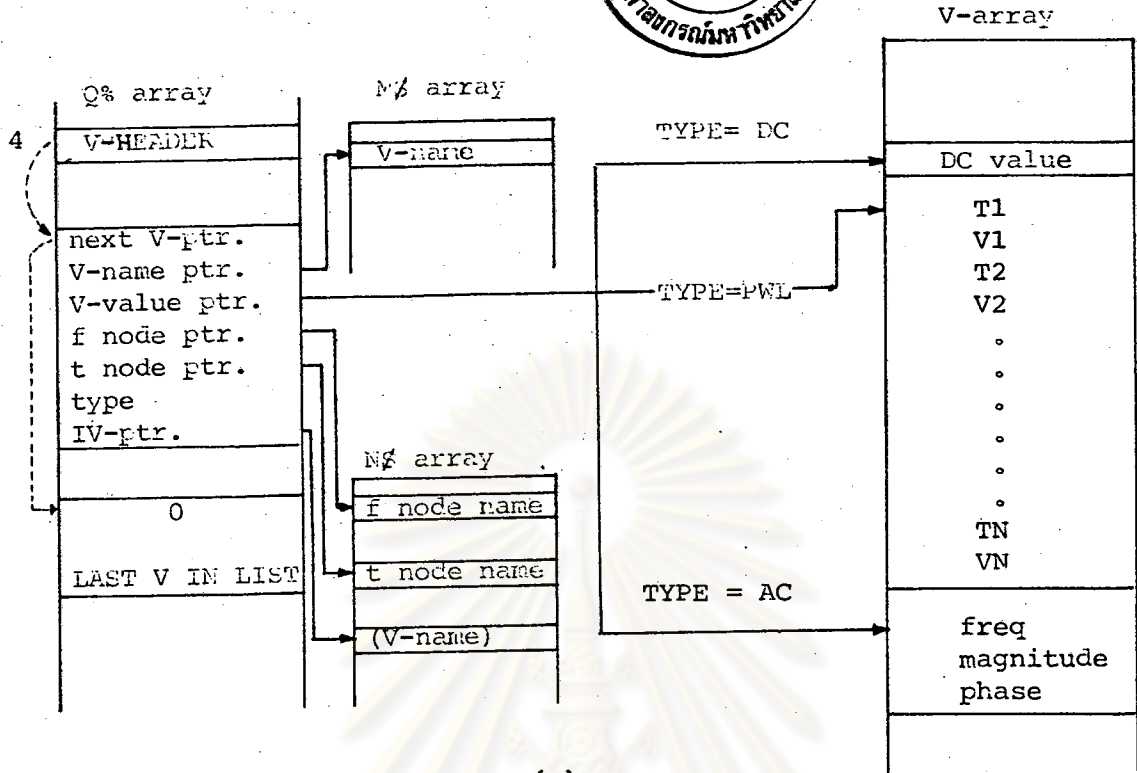
EDIT VOLTAGE SOURCE

TYPE OF VOLTAGE SOURCE): PWL)
 V-SOURCE NAME: VP1)
 FR NODE: 1)
 TO NODE: 0)
 PUT NUMBER OF VOLTAGE POINT : 4
 :::PUT VOLTAGE:::AT TIME T:::
 AT TIME: 0) V-VALUE: 0)
 AT TIME: 0.5) V-VALUE: 10)
 AT TIME: 1) V-VALUE: 0)
 AT TIME: 2) V-VALUE: 0)



หมายเหตุ รูปสัญญาณของแหล่งกำเนิดแรงดันจะทวนตัวมันเองไปเรื่อยๆ ถ้าเวลาที่คำนวณมากกว่าเวลาสูงสุดที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลให้

(ค)

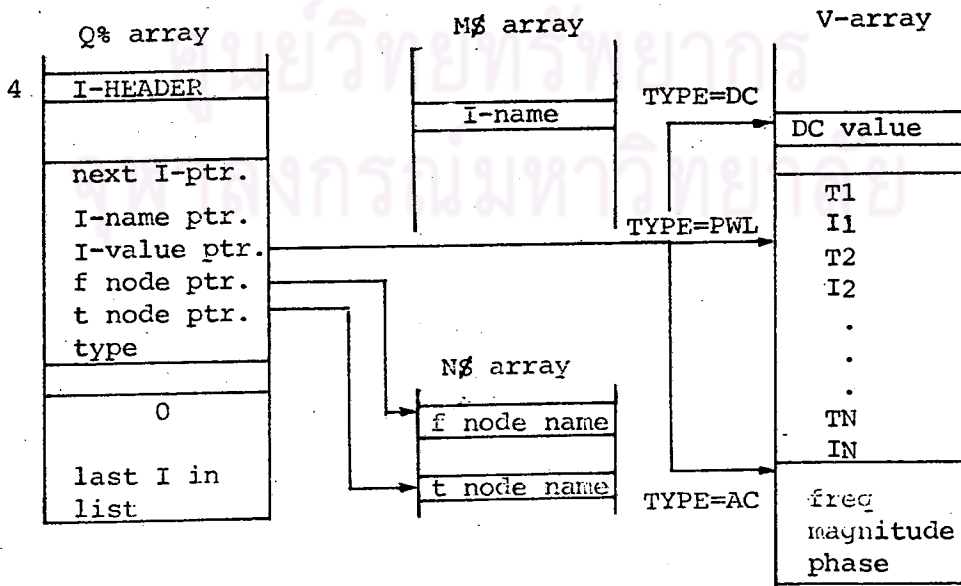


(จ)

รูปที่ 6.16 การใส่ข้อมูลของแหล่งกำเนิดแรงดัน

6.4.12 แหล่งกำเนิดกระแส

การใส่ข้อมูลของแหล่งกำเนิดกระแสมีลักษณะเหมือนการใส่ข้อมูลของแหล่งกำเนิดแรงดันทุกประการ ดังนั้นจึงแสดงเฉพาะการจัดข้อมูลใน array ของแหล่งกำเนิดกระแสดังในรูป 6.17



(ง)

รูปที่ 6.17 การจัดข้อมูลของแหล่งกำเนิดกระแส

6.5 คำสั่ง SIM LOAD SAVE CHANGE DISPLAY และ QUIT

6.5.1 คำสั่ง SIM

ผู้ใช้จะเลือกคำสั่งนี้ก็ต่อเมื่อได้ใส่ข้อมูลของวงจรเสร็จสิ้นแล้วและต้องการจะวิเคราะห์วงจร ข้อมูลของวงจรจะถูกโหลดเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลชื่อ "SF" บนจานแม่เหล็กก่อน และก็จะเริ่มโหลดโปรแกรมในส่วน "SIM" เข้ามาแทนและทำการ RUN ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป

6.5.2 คำสั่ง LOAD

คำสั่งนี้เป็นการโหลดข้อมูลของวงจรที่อยู่บนจานแม่เหล็กเข้ามาเก็บไว้ใน array ทั้งสิ้นผู้ใช้เพียงแต่ใส่ชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องการโหลดเข้ามาเท่านั้น

6.5.3 คำสั่ง SAVE

คำสั่งนี้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของวงจรลงในจานแม่เหล็กโดยผู้ใช้จะต้องกำหนดชื่อไฟล์ข้อมูลวงจรเสียก่อน เพื่อจะได้เรียกออกมาดูได้ภายหลัง

6.5.4 คำสั่ง CHANGE

เราจะใช้คำสั่ง CHANGE เมื่อต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวงจรโดยโปรแกรมจะถามถึงชนิดและชื่อของอุปกรณ์ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าตั้งเมนูที่แสดงในรูปที่ 6.18 และก็จะให้ข้อมูลของอุปกรณ์ที่เราต้องการเหมือนในหัวข้อ 6.5 เพื่อให้ผู้ใช้ใส่ค่าใหม่เข้าไป

CHANGE COMPONENT DATA

- 1 CHANGE R
- 2 CHANGE L
- 3 CHANGE C
- 4 CHANGE Q
- 5 CHANGE O
- 6 CHANGE Q-MODEL
- 7 CHANGE O-MODEL
- 8 CHANGE V-SOURCE
- 9 CHANGE I-SOURCE
- A CHANGE DIODE
- B CHANGE SWITCH
- C CHANGE D-MODEL
- D OUT OF CHANGE MODE

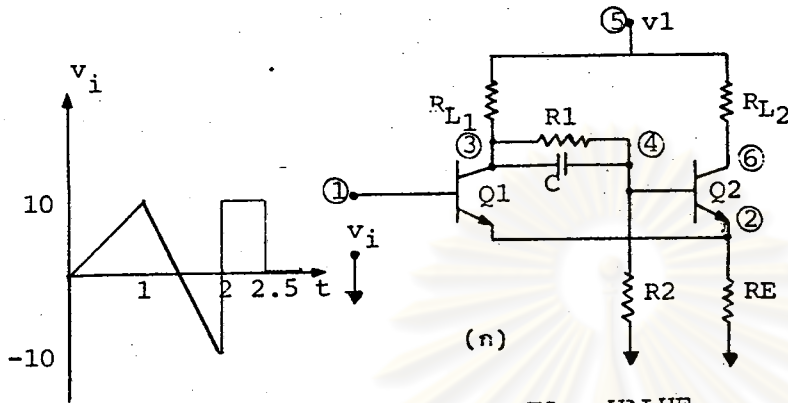
PUT MODE NUMBER YOU WANT:

PUT COMPONENT'S NAME:

รูปที่ 6.18 เมนูของคำสั่ง CHANGE

6.5.5 คำสั่ง DISPLAY

DISPLAY เป็นคำสั่งที่แสดงผลข้อมูลของวงจรที่อยู่ใน array ทั้งสี่ การแสดงข้อมูลนั้นจะเรียงชนิดของอุปกรณ์เป็นอย่างไร ไป ยกตัวอย่างวงจรในรูป 6.19 (ก) ซึ่งแสดงผลข้อมูลเป็นดังรูป 6.19 (ข)



```

R-NAME FR TO VALUE
RL1 3 5 4700.00001
RL2 5 6 3900.00001
R1 3 4 22000
R2 4 0 22000
RE 2 0 2200
C-NAME FR TO C-VALUE V PREV1
C 3 4 1E-06 10.7583
Q-NAME C B E MODEL VBE PREV VCB PREV
Q1 3 1 2 2SC 0 -3.3672
Q2 6 4 2 2SC 0 .71961
MODEL:HFE:HIE:CBE:CBC:VBE:RCE:ALFA-R
2SC 100 1000 1E-10 0 .7 9.99999999E+19 .5
V-NAME FR TO # VOLTAGE TYPE
V1 5 0 DC
DC-VALUE=12
V-NAME FR TO # VOLTAGE TYPE
V2 1 0 PWL
AT TIME:0 V-VALUE:0
AT TIME:1 V-VALUE:10
AT TIME:2 V-VALUE:-10
AT TIME:2 V-VALUE:10
AT TIME:2.5 V-VALUE:10
AT TIME:2.5 V-VALUE:0
AT TIME:3 V-VALUE:0
PRESS ANY KEY TO CONTINUE:

```

(ข)

รูปที่ 6.19 ลักษณะการแสดงผลข้อมูลของวงจร

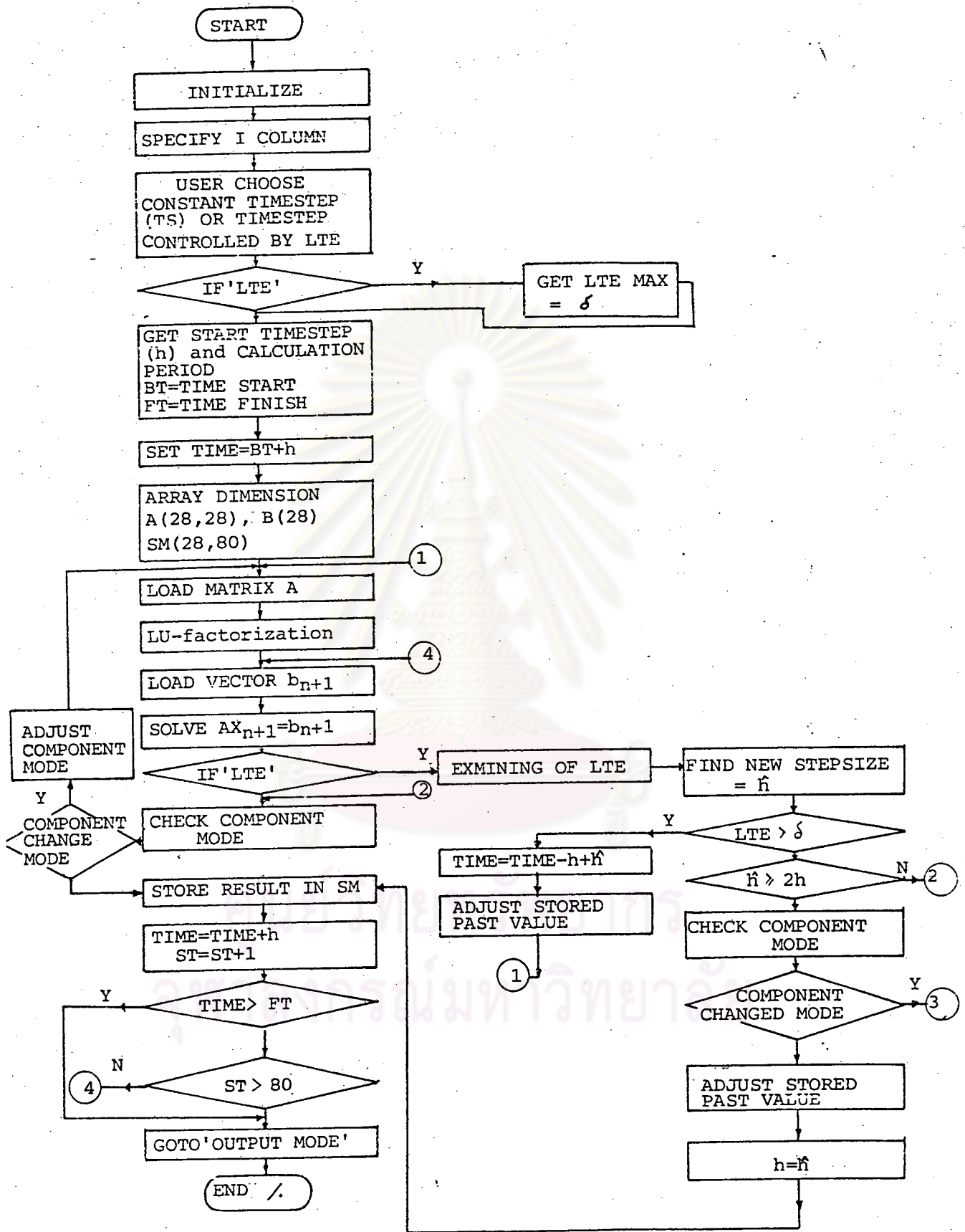
6.6 ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานในโมด SIM

ในโมดนี้เราสามารถแบ่งโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวิเคราะห์วงจรและส่วนเอาต์พุต ส่วนวิเคราะห์วงจรจะประกอบด้วย ส่วนสร้างและแก้สมการเมตริก ส่วนตรวจสอบและปรับขนาดขึ้นเวลา ส่วนตรวจสอบและปรับภาวะการทำงานของอุปกรณ์ไม่เชิงเส้น โปรแกรมจะรับข้อมูลของวงจรจากโมด INPUT ได้ 2 ทาง คือ รับจากหน่วยความจำส่วนบนที่โปรแกรมได้กำหนดพื้นที่สำหรับเก็บค่าต่างๆ ไว้แล้ว หรือรับผ่านทางจานแม่เหล็ก (จะรับข้อมูลผ่านจานแม่เหล็กเมื่อผู้ใช้ทำการคำนวณวงจรซ้ำในช่วงเวลาเดิมเท่านั้น) ส่วนข้อมูลในด้านที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรเช่น ขนาดขึ้นเวลา h และช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์นั้น ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลให้โปรแกรมในส่วนวิเคราะห์วงจรนี้ หลังจากได้ข้อมูลต่างๆ ครบแล้วโปรแกรมก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์และเมื่อเสร็จสิ้นการคำนวณโปรแกรมจะเข้าสู่ส่วนเอาต์พุตซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมส่วนเอาต์พุตเพื่อให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งที่ต้องการจะทำต่อ เช่น แสดงผลค่าตอบ ทำการพิมพ์ค่าตอบ ทำการคำนวณซ้ำหรืออื่นๆ ตามต้องการ

6.6.1 โปรแกรมส่วนวิเคราะห์วงจร

เราอาจกล่าวได้ว่าส่วนวิเคราะห์วงจรมันเป็นหัวใจของโปรแกรม 'TAPE' เนื่องจากขั้นตอนการวิเคราะห์วงจร และเทคนิคต่างๆ ที่ได้กล่าวมาตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 5 นั้นได้ถูกนำมาใช้ในโปรแกรมส่วนนี้ทั้งหมดซึ่งสามารถพิจารณาได้จากโฟลว์ชาร์ต (Flowchart) ของโปรแกรมส่วนวิเคราะห์วงจรในรูปที่ 6.20 และรายละเอียดของโฟลว์ชาร์ตซึ่งจะได้อธิบายโดยอ้างถึงเนื้อหา และสมการในบทที่ผ่านๆ มา ดังต่อไปนี้

เมื่อเข้าสู่ส่วนวิเคราะห์วงจร โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังในรูป 6.21 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าจะทำการวิเคราะห์แบบให้ขึ้นเวลาคงที่ (TS) หรือให้ขึ้นเวลาเปลี่ยนตามค่าของ LTE ซึ่งต้องกำหนดค่า LTE MAX (δ) กำหนดขึ้นเวลาเริ่มต้น (h) และสุดท้ายเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ (BT, FT) หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะกำหนดขนาดของเมตริกที่จะใช้ คือ $A(28,28)$, $B(28)$, และ $SM(28,80)$ และเริ่มการวิเคราะห์ที่จุดเวลา $BT+h$ โดยการสร้างสมการเมตริกจตุรัสของวงจร (เมตริก A) ด้วยวิธีโมดิฟายด์ไดแนลโดยอาศัยตราประจำอุปกรณ์ตามที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ 2.3, 3.8, 4.3 - 4.6 โครงสร้างการไหลของข้อมูลของเมตริก A แสดงไว้ในรูป 6.22 จากนั้นก็ทำการแปลงเมตริก A ให้อยู่ในรูปของเมตริก LxU ด้วยวิธีแยกตัวประกอบแอล-ยู เก็บไว้ในเมตริก A เดิม เวกเตอร์ค่าคงที่ b_{n+1} จะถูกสร้างขึ้นภายหลังและเก็บไว้ในเมตริก B ซึ่งโครงสร้างการไหลของข้อมูลในเมตริกของตัวแปรขาเข้าและค่าในอดีตต่างๆ แสดงไว้ในรูป 6.23 หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการแก้สมการ $Ax=B$ หาค่าตอบออกมา ถ้าผู้ใช้เลือกให้มีการปรับขนาดขึ้นเวลาตามค่าของ LTE ค่าตอบของสมการวงจรที่ได้จะถูกนำไปคำนวณหาค่า LTE ของอุปกรณ์พลวัต แต่ละตัวและดำเนินการไปตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 5.3 แต่ถ้าผู้ใช้กำหนดให้ขึ้นเวลาคงที่ (TS) โปรแกรมก็จะข้ามส่วนตรวจสอบและปรับขนาดขึ้นเวลานี้ไปทำการวิเคราะห์ในส่วนตรวจสอบและปรับภาวะการทำงานของอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นต่อไป ถ้าอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นเปลี่ยนภาวะการทำงานโปรแกรมส่วนนี้จะทำการเปลี่ยนภาวะของอุปกรณ์ที่เก็บไว้ใน Q% array เพื่อให้การไหลของข้อมูลของอุปกรณ์ในการสร้างเมตริก A ถูกต้องตามภาวะการทำงานจริงและทำการสร้างและแก้สมการวงจรซ้ำที่จุดเวลาเดิม



รูปที่ 6.20 โปรแกรมการคำนวณในโมด 'SIM'

SIMULATED PROG MODE:

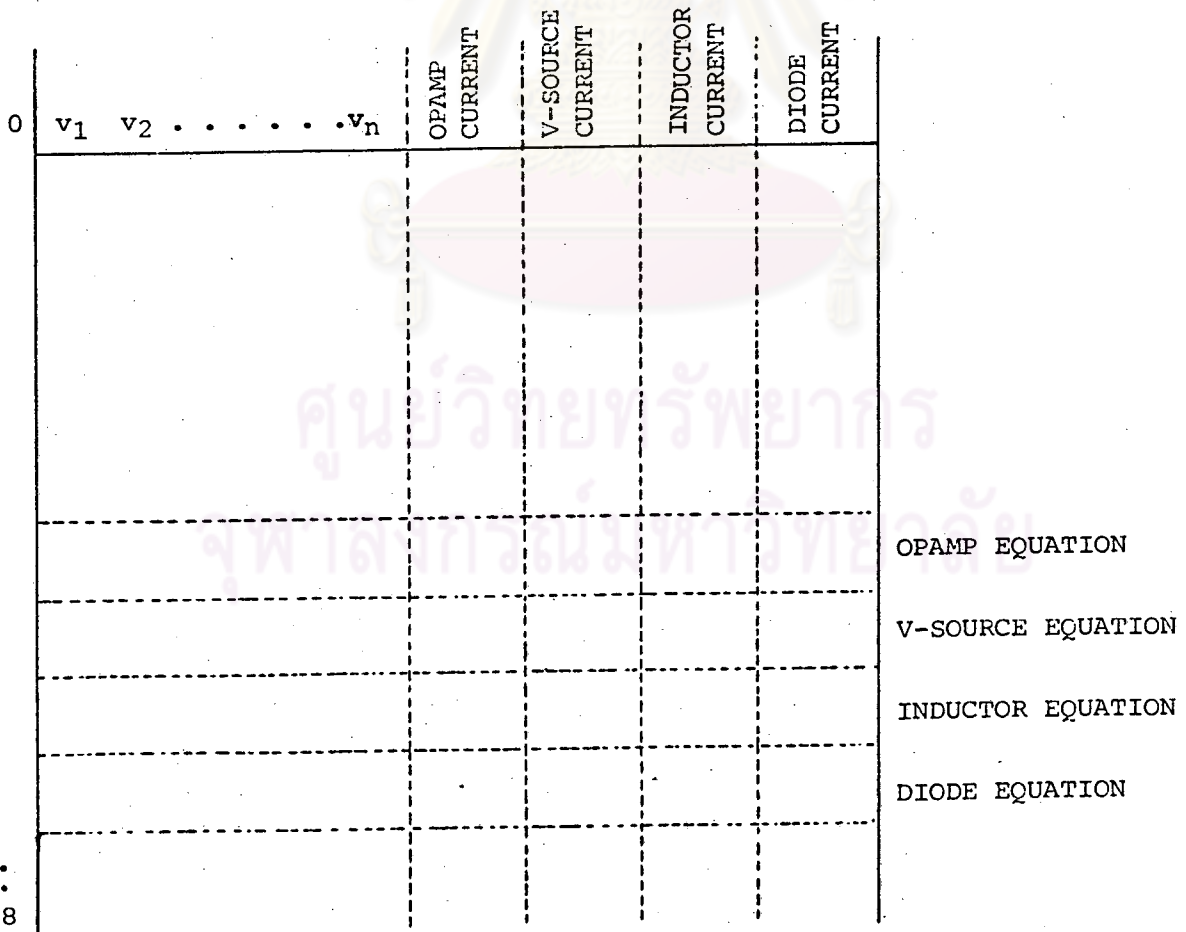
PUT LOCAL TRUNCATION AVAILABLE[LTE] OR TIMESTEP[TS]: ____

INPUT START TIMESTEP: ____

INPUT BEGIN TIME: ____

INPUT FINISH TIME: ____

รูปที่ 6.21 การแสดงข้อมูลทางจอภาพเมื่อเข้าไมตรีเคราะห์วงจร

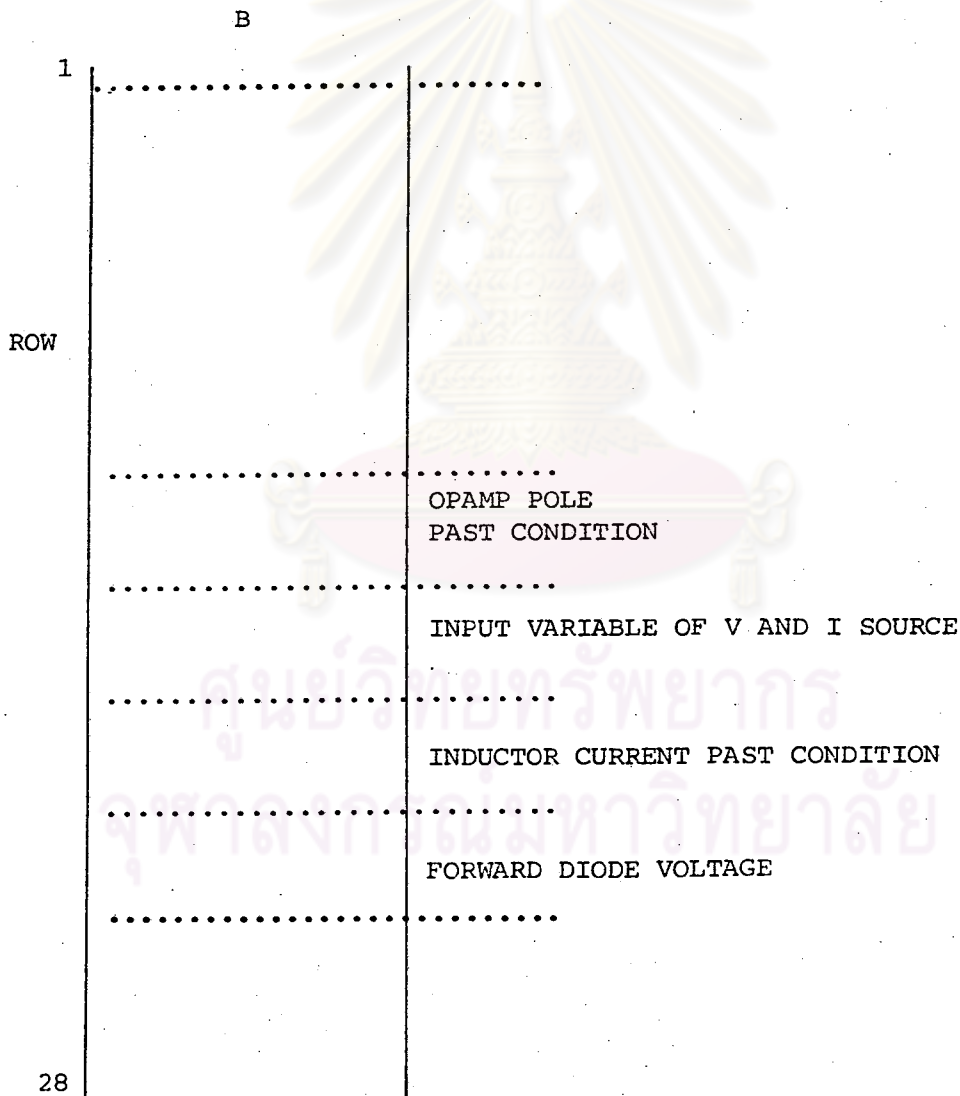


28

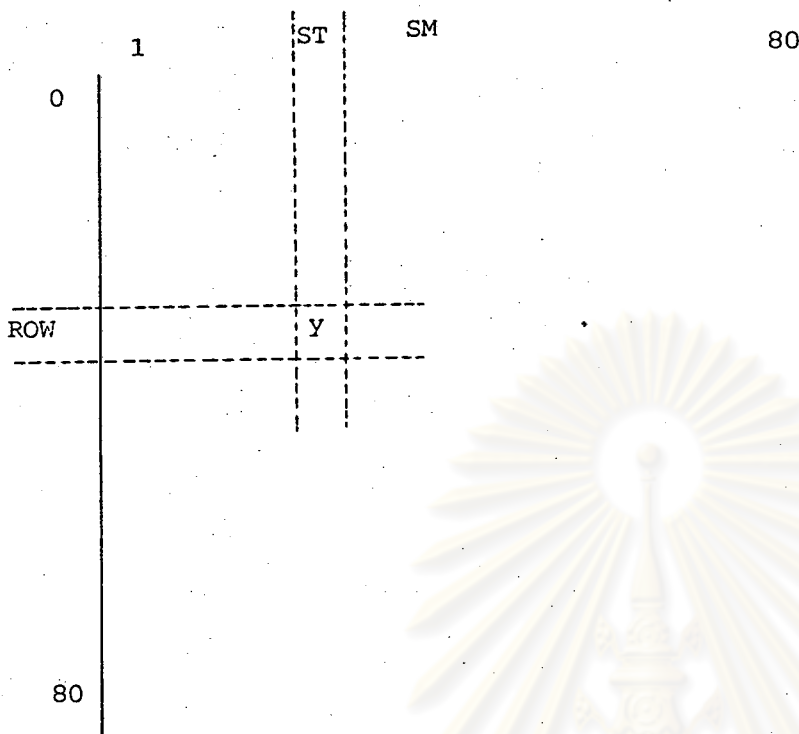
รูปที่ 6.22 โครงสร้างการไหลข้อมูลในเมตริก A

ถ้าหากอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นยังทำงานในภาวะเดิมค่าคอบที่ได้ (แรงดันในดทุกตัว กระแสของตัวเหนี่ยวนำ กระแสของสวิตช์ กระแสของออปแอมป์ และ กระแสของแหล่งกำเนิดแรงดัน) จะถูกเก็บไว้ในเมตริก SM ซึ่งเป็นเมตริกที่เก็บค่าตอบของแต่ละจุดเวลาและมีโครงสร้างดังในรูปที่ 6.24 ขณะเดียวกันก็ทำการปรับค่าในอดีตของอุปกรณ์พลวัตทุกตัวด้วย จากนั้นโปรแกรมจะไปทำการคำนวณที่จุดเวลาถัดไปถ้าหากจุดเวลานั้นมีค่าไม่เกินเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ [FT] หรือถ้าเมตริก SM ไม่เต็มเสียก่อน (นั่นคือ ผ่านจุดการคำนวณมาแล้ว 80 จุด)

เมื่อเสร็จสิ้นการคำนวณโปรแกรมส่วนเอาต์พุตจะรับหน้าที่ต่อโดยการแสดงข้อมูลทางจอภาพดังในรูปที่ 6.25 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 คำสั่ง ซึ่งเราจะอธิบายวิธีการใช้งานทั้ง 6 คำสั่งในหัวข้อต่อไป



รูปที่ 6.23 แสดงการไหลลดข้อมูลลงในเมตริก B



หมายเหตุ:

ในแต่ละ column (1 ถึง 80) ของ SM จะเก็บค่าตัวแปรของสมการที่จุดเวลาหนึ่งๆ และที่ตำแหน่ง SM(0, ST) ของแต่ละ COLUMN จะเก็บค่าจุดเวลาที่ทำการวิเคราะห์ ตามรูป $SM(B(ROW), ST) = Y$ และ $y = B(ROW)$



รูปที่ 6.24 โครงสร้างการเก็บผลการคำนวณในเมตริก SM

SIMULATED PROG MODE

- [1] LIST RESULT
- [2] CONTINUE CALCULATION
- [3] REPEAT CALCULATION
- [4] GOTO INPUT PROGRAM
- [5] PRINT RESULT
- [6] END

รูปที่ 6.25 การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพในโหมดเอาต์พุต

6.6.2 คำสั่งในส่วนเอาต์พุท

LIST RESULT และ PRINT RESULT เป็นคำสั่งแสดงค่าคอมของสมการวงจรถูกเก็บไว้ในเมตริก SM ซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้มีวิธีใช้งานเหมือนกันต่างกันตรงที่ LIST RESULT จะไม่มีการพิมพ์ผลข้อมูลออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น ผู้ใช้เพียงแต่กำหนดชื่อของโหนดที่ต้องการดูค่าแรงดันหรือกำหนดชื่อของไดโอด ออปแอมป์ แหล่งจ่ายแรงดัน ตัวเหนี่ยวนำและสวิตช์ที่ต้องการดูค่ากระแสไหลผ่านอุปกรณ์เหล่านี้โปรแกรมก็จะพิมพ์ผลให้ดังตัวอย่างในรูปที่ 6.26 ซึ่งเป็นค่าคอมของวงจรในรูปที่ 6.19 (ก)

รูปที่ 6.26 การแสดงผลทางจอภาพเมื่อ LIST RESULT และ PRINT RESULT

CONTINUE CALCULATION เมื่อผู้ใช้ต้องการคำนวณต่อจากจุดเวลาเดิมก็ให้ใช้คำสั่งนี้ โดยกำหนดจุดเวลา (FT) ใหม่ตามต้องการ

REPEAT CALCULATION เมื่อผู้ใช้ต้องการทำการคำนวณซ้ำในช่วงเวลาเดิม เพื่อทดลองหรือเปรียบเทียบผลการคำนวณโดยการเปลี่ยนแปลงขนาดขึ้นเวลาหรือ LTE นั้นก็ให้ใช้คำสั่งนี้ โมดนี้ก็จะทำการโหลดข้อมูลของวงจรจากจานแม่เหล็ก และภาวะเริ่มต้น (initial value) เข้ามาใหม่

GOTO INPUT PROGRAM คำสั่งนี้จะทำหน้าที่โหลดโปรแกรมโมด INPUT เข้ามาแทนที่โปรแกรมโมด SIM ใช้กรณีที่ผู้ใช้ต้องการกลับไปโมด INPUT เพื่อสร้างหรือแก้ไขวงจรใหม่

END ใช้เมื่อต้องการออกจาก 'TAPE'